



## (10) **DE 11 2019 004 265 T5** 2021.05.12

(12)

# Veröffentlichung

der internationalen Anmeldung mit der (87) Veröffentlichungs-Nr.: WO 2020/044991

in der deutschen Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)

(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2019 004 265.3

(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/JP2019/031036

(86) PCT-Anmeldetag: **07.08.2019** 

(87) PCT-Veröffentlichungstag: **05.03.2020**(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldu

(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung in deutscher Übersetzung: 12.05.2021 (51) Int Cl.: **H01L 33/38** (2010.01)

**H01L 33/42** (2010.01) **G09F 9/33** (2006.01)

(30) Unionspriorität:

2018-159251

28.08.2018 JP

(71) Anmelder:

SONY Semiconductor Solutions Corporation, Atsugi-shi, Kanagawa, JP

(74) Vertreter:

MFG Patentanwälte Meyer-Wildhagen Meggle-Freund Gerhard PartG mbB, 80799 München, DE (72) Erfinder:

Sugawara, Nobuhiro, Kikuchi-gun, Kumamoto,

JP; Hanzawa, Yasunari, Kikuchi-gun, Kumamoto,

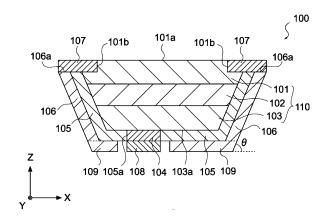
JP; Nozawa, Shinsuke, Kikuchi-gun, Kumamoto, JP; Shiozaki, Masaki, Kikuchi-gun, Kumamoto,

JP; Satou, Takeshi, Kikuchi-gun, Kumamoto, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: LICHTEMITTIERENDES ELEMENT UND ELEKTRONIKEINRICHTUNG

(57) Zusammenfassung: Bereitgestellt wird ein lichtemittierendes Element, dessen Bereich reduziert werden kann und in dem eine stabile elektrische Verbindung erzielt werden kann. Das lichtemittierende Element umfasst einen Stapel (110), eine erste Elektrode (107), eine zweite Elektrode (108), eine dritte Elektrode (109) und eine Seitenverdrahtung (106). Der Stapel enthält eine erste Halbleiterschicht (101), eine lichtemittierende Schicht (102) und eine zweite Halbleiterschicht (103), in dieser Reihenfolge gestapelt, und weist eine Lichtemissionsoberfläche (101a), eine Nicht-Lichtemissionsoberfläche (103a) und Seitenoberflächen (110a) auf. Die Seitenoberflächen sind so geneigt, dass die Distanz zwischen den Seitenoberflächen sich zu der Lichtemissionsoberfläche in einer Richtung parallel zu einer Schichtoberflächenrichtung des Stapels verbreitert. Die erste Elektrode (107) ist elektrisch mit der ersten Halbleiterschicht (101) verbunden und weist einen Abschnitt auf, der in einer Ausnehmung (101b) vorgesehen ist, die auf der Lichtemissionsoberfläche an einem peripheren Rand der ersten Halbleiterschicht (101) vorgesehen ist und mehr zu der lichtemittierenden Schicht als die Lichtemissionsoberfläche positioniert ist. Die zweite Elektrode (108) ist elektrisch mit der zweiten Halbleiterschicht (103) verbunden. Die dritte Elektrode ist gegenüber der zweiten Elektrode isoliert. Die Seitenverdrahtung (106) verbindet die erste Elektrode elektrisch mit der dritten Elektrode über die Seitenoberflächen.



### **Beschreibung**

## Erfindungsgebiet

**[0001]** Die vorliegende Technologie betrifft ein lichtemittierendes Element und eine Elektronikvorrichtung mit einer einseitigen Elektrodenstruktur.

#### Stand der Technik

[0002] In einem lichtemittierenden Element wie etwa einer Mikro-LED (Leuchtdiode) wird oft eine einseitige Elektrodenstruktur verwendet, in der eine p-Elektrode und eine n-Elektrode auf einer Seite eines Elements gebildet sind. Bei der einseitigen Elektrodenstruktur kann eine Flipchip-Montage oder dergleichen verwendet werden und das Montieren wird leichter.

**[0003]** Da eine p-Halbleiterschicht und eine n-Halbleiterschicht eine Positionsbeziehung von vorderer und hinterer Oberfläche des lichtemittierenden Elements aufweisen, ist es im Allgemeinen notwendig, um die p-Elektrode und die n-Elektrode auf der einen Seite zu platzieren, eine Elektrode mit der anderen Oberfläche elektrisch zu verbinden.

**[0004]** Beispielsweise offenbart Patentliteratur 1 ein lichtemittierendes Element, bei dem eine n-Mantelschicht und eine p-Mantelschicht über einer lichtemittierenden Schicht laminiert sind, das heißt, eine Elementoberfläche an einer n-Mantelschichtseite und die p-Mantelschicht sind elektrisch durch eine Verdrahtung verbunden, die an einer Seitenoberfläche des lichtemittierenden Elements vorgesehen ist. Die n-Elektrode und die p-Elektrode sind auf der Elementoberfläche an der n-Mantelschichtseite vorgesehen, um dadurch die einseitige Elektrodenstruktur zu realisieren.

#### Entgegenhaltungsliste

#### Patentliteratur

**[0005]** Patentliteratur 1: Japanische offengelegte Patentanmeldung Nr. 2013-157496

### Offenbarung der Erfindung

#### **Technisches Problem**

**[0006]** In der wie in Patentliteratur 1 beschriebenen Struktur gibt es jedoch Probleme, dass das Reduzieren eines Elementbereichs begrenzt ist, ein Verbindungsbereich der Seitenverdrahtung zu der p-Mantelschicht begrenzt ist und eine elektrische Verbindung nicht stabilisiert ist.

[0007] Angesichts der obigen Umstände besteht eine Aufgabe der vorliegenden Technologie in der Bereitstellung eines lichtemittierenden Elements und eine

ner Elektronikvorrichtung, die in der Lage sind, den Elementbereich zu reduzieren und eine stabile elektrische Verbindung zu realisieren.

#### Lösung des Problems

**[0008]** Zur Lösung der obigen Aufgabe enthält ein lichtemittierendes Element gemäß der vorliegenden Technologie ein Laminat, eine erste Elektrode, eine zweite Elektrode, eine dritte Elektrode und eine Seitenverdrahtung.

[0009] Das Laminat, bei dem eine erste Halbleiterschicht mit einem ersten Halbleitertyp, eine lichtemittierende Schicht und eine zweite Halbleiterschicht mit einem zweiten Halbleitertyp in dieser Reihenfolge laminiert sind, enthält eine lichtemittierende Oberfläche an einer Oberfläche gegenüber der lichtemittierenden Schicht der ersten Halbleiterschicht, von der in der lichtemittierenden Schicht erzeugtes Licht emittiert wird, eine nicht-lichtemittierende Oberfläche an einer Oberfläche gegenüber der lichtemittierenden Schicht der zweiten Halbleiterschicht und einer Seitenoberfläche, die zwischen der lichtemittierenden Oberfläche und der nicht-lichtemittierenden Oberfläche verbindet, und die Seitenoberfläche ist so geneigt, dass eine Distanz zwischen den Seitenoberflächen aus einer Richtung senkrecht zu einer Schichtoberflächenrichtung des Laminats sich zu der lichtemittierenden Oberfläche erstreckt.

**[0010]** Die erste Elektrode ist elektrisch mit der ersten Halbleiterschicht verbunden, ist in einem konkaven Abschnitt angeordnet, der in der lichtemittierenden Oberfläche an einer Peripherie der ersten Halbleiterschicht vorgesehen ist, und weist einen Abschnitt auf, der näher an einer Seite der lichtemittierenden Schicht liegt als die lichtemittierende Oberfläche.

**[0011]** Die zweite Elektrode ist auf einer Seite der nicht-lichtemittierenden Oberfläche des Laminats vorgesehen und ist elektrisch mit dem zweiten Halbleiter verbunden.

**[0012]** Die dritte Elektrode ist auf der Seite der nichtlichtemittierenden Oberfläche des Laminats vorgesehen und ist von der zweiten Elektrode isoliert.

**[0013]** Die Seitenverdrahtung verbindet die erste Elektrode und die dritte Elektrode über die Seitenoberfläche elektrisch.

[0014] Gemäß dieser Konfiguration ist es durch Neigen der Seitenoberfläche des Laminats wie oben beschrieben möglich, die erste Elektrode zu einem zentralen Abschnitt des lichtemittierenden Elements zu bringen und den Elementbereich des lichtemittierenden Elements zu reduzieren (Chipschrumpfung). Weiter wird der Kontaktbereich der ersten Elektro-

de und der ersten Halbleiterschicht vergrößert, es ist möglich, die elektrische Verbindung zwischen der ersten Elektrode und der ersten Halbleiterschicht zu stabilisieren.

**[0015]** Eine Tiefe des konkaven Abschnitts von der lichtemittierenden Oberfläche kann größer sein als eine Dicke der ersten Halbleiterschicht zwischen der ersten Elektrode und der lichtemittierenden Schicht.

[0016] Eine Gesamtheit von der ersten Elektrode kann näher bei der Seite der lichtemittierenden Schicht als die lichtemittierende Oberfläche liegen.

[0017] Die erste Elektrode kann einen ersten Abschnitt, der näher an der Seite der lichtemittierenden Schicht liegt als die lichtemittierende Oberfläche, und einen zweiten Abschnitt, der auf der lichtemittierenden Oberfläche vorgesehen ist und die lichtemittierende Oberfläche bedeckt, enthalten.

**[0018]** Die erste Halbleiterschicht kann ein Gebiet hoher Verunreinigung auf der Seite der lichtemittierenden Oberfläche aufweisen, und der zweite Abschnitt kann mit dem Gebiet hoher Verunreinigung in Kontakt stehen.

**[0019]** Das lichtemittierende Element kann weiter eine transparente leitfähige Schicht enthalten, die aus einem transparenten leitfähigen Material gebildet ist, die auf die lichtemittierende Oberfläche laminiert ist, und der zweite Abschnitt kann mit der transparenten leitfähigen Schicht in Kontakt stehen.

**[0020]** Die erste Elektrode kann mit einer Stirnfläche der Seite der lichtemittierenden Schicht der Seitenverdrahtung in Kontakt stehen.

**[0021]** Die erste Elektrode kann mit einer inneren Oberfläche in Kontakt stehen, die eine Oberfläche einer Laminatseite der Seitenverdrahtung ist.

**[0022]** Der erste Abschnitt kann mit der inneren Oberfläche, der eine Oberfläche der Laminatseite der Seitenverdrahtung ist, und der Stirnfläche der Seite der lichtemittierenden Oberfläche der Seitenverdrahtung in Kontakt stehen.

**[0023]** Das lichtemittierende Element kann mehrere der ersten Elektroden enthalten.

[0024] Zur Lösung der obigen Aufgabe enthält eine Elektronikvorrichtung gemäß der vorliegenden Technologie ein lichtemittierendes Element. Das lichtemittierende Element enthält ein Laminat, bei dem eine erste Halbleiterschicht mit einem ersten Halbleitertyp, eine lichtemittierende Schicht und eine zweite Halbleiterschicht mit einem zweiten Halbleitertyp in dieser Reihenfolge laminiert sind einschließlich einer lichtemittierenden Oberfläche an einer Oberfläche gegen-

über der lichtemittierenden Schicht der ersten Halbleiterschicht, von der in der lichtemittierenden Schicht erzeugtes Licht emittiert wird, einer nicht-lichtemittierenden Oberfläche an einer Oberfläche gegenüber der lichtemittierenden Schicht der zweiten Halbleiterschicht und einer Seitenoberfläche, die zwischen der lichtemittierenden Oberfläche und der nicht-lichtemittierenden Oberfläche verbindet, wobei die Seitenoberfläche so geneigt ist, dass eine Distanz zwischen den Seitenoberflächen aus einer Richtung senkrecht zu einer Schichtoberflächenrichtung des Laminats sich zu der lichtemittierenden Oberfläche erstreckt: eine erste Elektrode, die elektrisch mit der ersten Halbleiterschicht verbunden ist, in einem konkaven Abschnitt angeordnet, der in der lichtemittierenden Oberfläche an einer Peripherie der ersten Halbleiterschicht vorgesehen ist, und mit einem Abschnitt, der näher an einer Seite der lichtemittierenden Schicht liegt als die lichtemittierende Oberfläche; eine zweite Elektrode, die auf einer Seite der nicht-lichtemittierenden Oberfläche des Laminats vorgesehen und elektrisch mit dem zweiten Halbleiter verbunden ist; eine dritte Elektrode, die auf der Seite der nicht-lichtemittierenden Oberfläche des Laminats vorgesehen und von der zweiten Elektrode isoliert ist; und eine Seitenverdrahtung, die die erste Elektrode und die dritte Elektrode über die Seitenoberfläche elektrisch verbindet.

### Figurenliste

- **Fig. 1** ist ein Querschnittsdiagramm eines lichtemittierenden Elements gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Technologie.
- **Fig. 2** ist ein Draufsichtsdiagramm des lichtemittierenden Elements gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.
- **Fig. 3** ist ein Querschnittsdiagramm eines Laminats, das in dem lichtemittierenden Element enthalten ist, gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.
- **Fig. 4** ist ein Schemadiagramm, das einen Effekt des lichtemittierenden Elements gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie zeigt.
- **Fig. 5** ist ein Querschnittsdiagramm des lichtemittierenden Elements gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.
- **Fig. 6** ist ein Querschnittsdiagramm des Laminats, das in dem lichtemittierenden Element enthalten ist, gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.
- **Fig. 7** ist ein Querschnittsdiagramm des lichtemittierenden Elements gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.

- **Fig. 8** ist ein Querschnittsdiagramm des lichtemittierenden Elements gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.
- **Fig. 9** ist ein Querschnittsdiagramm des lichtemittierenden Elements gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.
- **Fig. 10** ist ein Querschnittsdiagramm des lichtemittierenden Elements gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.
- **Fig. 11** ist ein Querschnittsdiagramm des lichtemittierenden Elements gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.
- **Fig. 12** ist ein Querschnittsdiagramm des lichtemittierenden Elements gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.
- **Fig. 13** ist ein Draufsichtsdiagramm des lichtemittierenden Elements gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.
- **Fig. 14** ist ein Draufsichtsdiagramm des lichtemittierenden Elements gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.
- **Fig. 15** ist ein Draufsichtsdiagramm des lichtemittierenden Elements gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie.

Modus/Modi zum Ausführen der Erfindung

**[0025]** Ein lichtemittierendes Element gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Technologie wird beschrieben.

[Struktur des lichtemittierenden Elements]

[0026] Fig. 1 ist ein Querschnittsdiagramm, das eine Struktur eines lichtemittierenden Elements 100 gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Technologie zeigt, und Fig. 2 ist ein Draufsichtsdiagramm des lichtemittierenden Elements. Fig. 1 ist ein Querschnittsdiagramm entlang einer Linie A-A von Fig. 2.

[0027] Das lichtemittierende Element 100 ist eine Leuchtdiode, insbesondere geeigneterweise eine Mikro-LED.

[0028] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt, enthält das lichtemittierende Element 100 eine erste Halbleiterschicht 101, eine lichtemittierende Schicht 102, eine zweite Halbleiterschicht 103, eine Kontaktschicht 104, eine Isolierschicht 105, eine Seitenverdrahtung 106, erste Elektroden 107, eine zweite Elektrode 108 und dritte Elektroden 109.

[0029] Die erste Halbleiterschicht 101, die lichtemittierende Schicht 102 und die zweite Halbleiterschicht 103 sind in dieser Reihenfolge laminiert und bilden das Laminat 110. Im Folgenden ist eine Laminierrichtung der ersten Halbleiterschicht 101, der lichtemittie-

renden Schicht **102** und der zweiten Halbleiterschicht **103** als die X-Y-Richtung gesetzt, und die Laminierrichtung ist als die Z-Richtung gesetzt.

**[0030]** Die erste Halbleiterschicht **101** ist aus einem p-Halbleiter oder einem n-Halbleiter gebildet. Die erste Halbleiterschicht **101** ist aus dem p-Halbleiter gebildet, z. B.  $(Al_{0,7}Ga_{0,3})_{0,5}In_{0,5}P$  vom p-Typ mit einer Trägerkonzentration von 1 × 10<sup>17</sup> bis 1 × 10<sup>18</sup>. Weiter ist die erste Halbleiterschicht **101** aus dem n-Halbleiter gebildet, z. B.  $(Al_{0,7}Ga_{0,3})_{0,5}In_{0,5}P$  vom n-Typ mit einer Trägerkonzentration von 1 × 1018.

[0031] Die lichtemittierende Schicht 102 ist eine Schicht, die Licht durch Rekombination von Elektronen und Löchern emittiert. Die lichtemittierende Schicht 102 kann beispielsweise eine Quantenmuldenstruktur aufweisen, in der mehrere Quantenmuldenschichten einschließlich InGaP und Barriereschichten einschließlich (Al<sub>0.6</sub>Ga<sub>0.4</sub>) <sub>0.5</sub>In<sub>0.5</sub>P abwechselnd laminiert sind. Weiterhin kann die lichtemittierende Schicht 102 eine beliebige Struktur sein, die aufgrund einer anderen Rekombination zusätzlich zu dieser Licht emittiert.

**[0032]** Die zweite Halbleiterschicht **103** ist aus einem Halbleiter vom n-Halbleiter oder p-Halbleiter gebildet, der einen anderen Halbleitertyp von der ersten Halbleiterschicht **101** aufweist. Die zweite Halbleiterschicht **103** ist aus dem n-Halbleiter gebildet, zum Beispiel n-  $(Al_{0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}P$  mit einer Trägerkonzentration von 1 × 10<sup>18</sup>. Weiter ist die zweite Halbleiterschicht **103** aus dem p-Halbleiter gebildet, z. B. p- $(Al_{0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}P$  mit einer Trägerkonzentration von 1 × 10<sup>17</sup> bis 1 × 10<sup>18</sup>.

[0033] Wenn in dem Laminat 110 eine Spannung zwischen der ersten Halbleiterschicht 101 und der zweiten Halbleiterschicht 103 angelegt wird, tritt in der lichtemittierenden Schicht 102 eine Lichtemission auf. Licht wird durch die erste Halbleiterschicht 101 emittiert. Im Folgenden wird eine Oberfläche der ersten Halbleiterschicht 101 auf einer gegenüberliegenden Seite zu der lichtemittierenden Schicht 102 als eine lichtemittierende Oberfläche der zweiten Halbleiterschicht 103 auf einer gegenüberliegenden Seite zu der lichtemittierenden Schicht 102 als eine nicht-lichtemittierende Oberfläche 103a bezeichnet.

[0034] Fig. 3 ist ein Querschnittsdiagramm, das nur das Laminat 110 zeigt. Wie in der gleichen Zeichnung gezeigt, weist das Laminat 110 Seitenoberflächen 110a auf, die jeweils zwischen der lichtemittierenden Oberfläche 101a und der nicht-lichtemittierenden Oberfläche 103a verbinden.

[0035] Jede Seitenoberfläche 110a ist so geneigt, dass sich die Distanz zwischen den Seitenoberflächen 110a aus einer Richtung (Z-Richtung) senkrecht

zu einer Schichtoberflächenrichtung (X-Y-Richtung) des Laminats **110** zu der lichtemittierenden Oberfläche **101a** erstreckt. Das heißt, wenn ein durch die Schichtoberflächenrichtung (X-Y-Richtung) und jede Seitenoberfläche **110a** gebildeter Winkel 9 ist, ist 9 kleiner als 90°.

[0036] Weiter sind, wie in Fig. 3 gezeigt, konkave Abschnitte 101b an einer Peripherie der ersten Halbleiterschicht 101 vorgesehen. Jeder konkave Abschnitt 101b wird durch Graben hinunter bis zu einer vorbestimmten Tiefe von der lichtemittierenden Oberfläche 101a gebildet, und eine Tiefe t jedes konkaven Abschnitts 101b kann zwischen der lichtemittierenden Oberfläche 101a und der lichtemittierenden Schicht 102 eingestellt werden. Insbesondere kann die Tiefe t 300 nm oder mehr und 400 nm oder weniger betragen.

[0037] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist in einer inneren peripheren Oberfläche jedes konkaven Abschnitts 101b eine Oberfläche parallel zu der Schichtoberflächenrichtung (X-Y-Richtung) als eine Bodenoberfläche 101c definiert, und eine Oberfläche parallel zu der Laminierrichtung (Z-Richtung) ist als eine Seitenoberfläche 101d definiert.

[0038] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist in jedem konkaven Abschnitt 101b eine erste Elektrode 107 vorgesehen. Die Anzahl und eine Anordnung der konkaven Abschnitte 101b können unterschiedliche Konfigurationen aufweisen, wie später beschrieben werden wird.

[0039] Die Kontaktschicht 104 ist zwischen der zweiten Halbleiterschicht 103 und der zweiten Elektrode 108 vorgesehen, um die zweite Halbleiterschicht 103 und die zweite Elektrode 108 elektrisch zu verbinden. Die Kontaktschicht 104 ist aus einem leitfähigen Material gebildet, d.h., ist aus dem n-GaAs gebildet, wenn die zweite Halbleiterschicht 103 ein n-Halbleiter ist, und ist aus p-GaAs, p-GaP, p-AlGaAs oder dergleichen gebildet, wenn die zweite Halbleiterschicht 103 der p-Halbleiter ist.

[0040] Die Isolierschicht 105 bedeckt und isoliert die nicht-lichtemittierende Oberfläche 103a und die Seitenoberflächen 110a des Laminats 110. Die Isolierschicht 105 ist aus einem transparenten schützenden Material gebildet und kann beispielsweise aus SiO<sub>2</sub>, SiN, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder dergleichen gebildet werden. Eine mit der nicht-lichtemittierenden Oberfläche 103a kommunizierende Öffnung 105a ist auf der nicht-lichtemittierenden Oberfläche 103a vorgesehen, und die Kontaktschicht 104 ist in der Öffnung 105a vorgesehen.

[0041] Die Seitenverdrahtung 106 ist auf der Isolierschicht 105 auf jeder Seitenoberfläche 110a angeordnet und verbindet jede erste Elektrode 107 und jede dritte Elektrode 109 elektrisch über jede Seitenoberfläche 110a. Wie in Fig. 1 gezeigt, ist die Seitenverdrahtung 106 mit jeder ersten Elektrode 107 durch Kontaktieren einer Stirnoberfläche 106a auf einer Seite der lichtemittierenden Oberfläche 101a mit jeder ersten Elektrode 107 verbunden. Außerdem fungiert die Seitenverdrahtung 106 auch als ein Lichtreflektor, der von der lichtemittierenden Schicht 102 emittiertes Licht zu der Seite der lichtemittierenden Oberfläche 101a reflektiert.

[0042] Die Seitenverdrahtung 106 ist aus einem Material mit Leitfähigkeit und mit Lichtreflexionsvermögen gebildet und kann beispielsweise aus Au gebildet sein. Eine Dicke der Seitenverdrahtung 106 kann beispielsweise 300 nm oder mehr und 400 nm oder weniger betragen. Übrigens kann die Seitenverdrahtung 106 durch Sputtern gebildet werden. Da die Seitenoberflächen 110a wie oben beschrieben geneigt sind, kann die Seitenverdrahtung 106 leicht aus einer Seite der nicht-lichtemittierenden Oberfläche 103a im Vergleich zu dem Fall, wo die Seitenoberflächen 110a nicht geneigt sind, gebildet werden.

[0043] Jede erste Elektrode 107 ist elektrisch mit der ersten Halbleiterschicht 101 verbunden und ist über die Seitenverdrahtung 106 elektrisch mit der dritten Elektrode 109 verbunden. Jede erste Elektrode 107 ist in jedem konkaven Abschnitt 101b angeordnet und befindet sich näher an der lichtemittierenden Schicht 102 als jede lichtemittierende Oberfläche 101a. Obwohl in Fig. 1 eine Gesamtheit der ersten Elektrode 107 sich näher an einer Seite der lichtemittierenden Schicht 102 als der lichtemittierenden Oberfläche 101a befindet, kann sich aber, wie später beschrieben werden wird, ein Teil jeder ersten Elektrode 107 näher an der Seite der lichtemittierenden Schicht 102 als die lichtemittierende Oberfläche 101a befinden. Die erste Elektrode 107 kann eine Gestalt in Kontakt mit der Bodenoberfläche 101c und der Seitenoberfläche 101d des konkaven Abschnitts 101b aufweisen.

[0044] Wie in Fig. 2 gezeigt, kann das lichtemittierende Element 100 zwei erste Elektroden 107 enthalten. Weiter kann das lichtemittierende Element 100 eine erste Elektrode 107 enthalten und kann drei oder mehr erste Elektroden 107 enthalten.

[0045] Die erste Elektrode 107 ist aus einem Material mit Leitfähigkeit gebildet, d.h., kann aus p-GaAs, p-GaP oder p-AlGaAs gebildet sein, wenn die erste Halbleiterschicht 101 vom p-Typ ist, oder kann aus n-GaAs gebildet sein, wenn die erste Halbleiterschicht 101 vom n-Typ ist. Eine Dicke jeder ersten Elektrode 107 ist geeigneterweise die gleiche wie die Tiefe jedes konkaven Abschnitts 101b und kann 300 nm oder mehr und 400 nm oder weniger betragen.

[0046] Die zweite Elektrode 108 ist auf der Seite der nicht-lichtemittierenden Oberfläche 103a des Laminats 110 vorgesehen und ist elektrisch mit der zweiten Halbleiterschicht 103 verbunden. Die zweite Elek-

trode **108** kann auf der Kontaktschicht 104 ausgebildet sein und kann über die Kontaktschicht 104 elektrisch mit der zweiten Halbleiterschicht **103** verbunden sein. Die zweite Elektrode **108** ist aus einem leitfähigen Material gebildet und kann beispielsweise aus Au gebildet sein.

[0047] Jede dritte Elektrode 109 ist auf der Seite der nicht-lichtemittierenden Oberfläche 103a des Laminats 110 vorgesehen und ist von der zweiten Elektrode 108 isoliert. Jede dritte Elektrode 109 kann von der zweiten Elektrode 108 auf der Isolierschicht 105 beabstandet sein. Jede dritte Elektrode 109 ist über die Seitenverdrahtung 106 elektrisch mit der ersten Elektrode 107 verbunden, d.h., ist elektrisch mit der ersten Halbleiterschicht 101 verbunden. Jede dritte Elektrode 109 ist aus einem leitfähigen Material gebildet und kann beispielsweise aus Au gebildet sein.

[0048] Das lichtemittierende Element 100 weist die oben beschriebene Konfiguration auf. Jede zweite Elektrode 108 und jede dritte Elektrode 109, elektrisch mit jeder ersten Halbleiterschicht 101 und jeder zweiten Halbleiterschicht 103 verbunden, sind auf der gleichen Oberfläche der Seite der nicht-lichtemittierenden Oberfläche 103a bezüglich des Laminats 110 vorgesehen. Somit wird eine einseitige Elektrodenstruktur realisiert.

[Effekt des lichtemittierenden Elements]

[0049] Der Effekt des lichtemittierenden Elements 100 wird beschrieben. Fig. 4 ist ein Diagramm, das den Effekt des lichtemittierenden Elements 100 zeigt, und ist ein Diagramm, das die Größen des lichtemittierenden Elements 200 und des lichtemittierenden Elements 300 gemäß einem Vergleichsbeispiel und dem lichtemittierenden Element 100 gemäß der vorliegenden Ausführungsform vergleicht.

**[0050]** Das lichtemittierende Element 200 enthält eine erste Halbleiterschicht 201, eine lichtemittierende Schicht 202, eine zweite Halbleiterschicht 203, eine Kontaktschicht 204, eine Isolierschicht 205, eine Seitenverdrahtung 206, erste Elektroden 207, eine zweite Elektrode 208 und dritte Elektroden 209. Die erste Halbleiterschicht 201, die lichtemittierende Schicht 202 und die zweite Halbleiterschicht 203 sind laminiert, um ein Laminat 210 zu konfigurieren.

**[0051]** In der Struktur des lichtemittierenden Elements 200 ist jede Seitenoberfläche 210a des Laminats 210 senkrecht zu der Schichtoberflächenrichtung. Der Herstellungsprozess des lichtemittierenden Elements 200 muss die Seitenverdrahtung 206 bilden, nachdem jede erste Elektrode 207 gebildet ist.

[0052] Das lichtemittierende Element 300 enthält eine erste Halbleiterschicht 301, eine lichtemittierende Schicht 302, eine zweite Halbleiterschicht 303, eine

Kontaktschicht 304, eine Isolierschicht 305, eine Seitenverdrahtung 306, erste Elektroden 307, eine zweite Elektrode 308 und dritte Elektroden 309. Die erste Halbleiterschicht 301, die lichtemittierende Schicht 302 und die zweite Halbleiterschicht 303 sind laminiert, um ein Laminat 310 zu konfigurieren.

[0053] Das lichtemittierende Element 300 weist eine Elementbreite H1 gleich der des lichtemittierenden Elements 200 auf und weist eine Struktur auf, bei der jede Seitenoberfläche 310a des Laminats 310 geneigt ist. In dieser Struktur wird in der lichtemittierenden Schicht 302 erzeugtes Licht durch Neigen jeder Seitenoberfläche 310a zu jeder lichtemittierenden Oberfläche 301a reflektiert, so dass die Lichtemissionseffizienz verbessert werden kann.

**[0054]** Außerdem ist es unnötig, die Seitenverdrahtung 306 über den ersten Elektroden 307 zu bilden, und die Anzahl des Herstellungsprozesses kann reduziert werden.

**[0055]** Das lichtemittierende Element **100** kann die Elementbreite bezüglich der Konfiguration des lichtemittierenden Elements 300 weiter reduzieren.

[0056] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist in dem lichtemittierenden Element 100 jede erste Elektrode 107 so angeordnet, dass sie sich von der lichtemittierenden Oberfläche 101a bezüglich des lichtemittierenden Elements 300 zu der Seite der lichtemittierenden Schicht 102 bewegt. Eine Bewegungsdistanz der ersten Elektrode 107 von der lichtemittierenden Schicht 102 ist gleich der Tiefe t des konkaven Abschnitts 101b.

[0057] Durch Bewegen jeder ersten Elektrode 107 zu der Seite der lichtemittierenden Schicht 102 kann jede erste Elektrode 107 entlang einer Neigung jeder Seitenoberfläche 110a zu einem zentralen Abschnitt des lichtemittierenden Elements 100 bewegt werden, während ein Bereich der lichtemittierenden Oberfläche 101a (Breite S in der Zeichnung) beibehalten wird. Insbesondere, wie in Fig. 4 gezeigt, wenn eine verschmälerte Breite w des lichtemittierenden Elements 100 bezüglich des lichtemittierenden Elements 300 durch t/tanθ dargestellt wird. Infolgedessen wird die Breite des lichtemittierenden Elements 100 von der Breite H1 zu einer Breite H2 reduziert.

[0058] Auf diese Weise ist es bei dem lichtemittierenden Element 100 möglich, die Elementbreite zu reduzieren (Chipschrumpfen). Weiter wird durch Neigen jeder Seitenoberfläche 110a auch eine Verbesserung bei der Lichtextraktionseffizienz realisiert.

[Anordnung der ersten Elektrode]

[0059] Jede erste Elektrode 107 kann näher an der lichtemittierenden Schicht 102 angeordnet sein.

Fig. 5 ist ein Querschnittsdiagramm des lichtemittierenden Elements 100, bei dem jede erste Elektrode 107 näher an der lichtemittierenden Schicht 102 liegt, und Fig. 6 ist ein Querschnittsdiagramm des Laminats 110 in diesem Fall.

[0060] Wie in Fig. 6 gezeigt, weist jeder konkave Abschnitt 101b eine Tiefe t2 auf, die noch tiefer ist als die Tiefe t. Falls die Dicke d der ersten Halbleiterschicht 101 zwischen jeder ersten Elektrode 107 (siehe Fig. 5) und der lichtemittierenden Schicht 102, kann die Tiefe t2 größer sein als die Dicke d. Insbesondere kann die Tiefe t2 beispielsweise 1100 nm oder mehr und 1300 nm betragen.

[0061] Man beachte, dass die Tiefe t2 auf eine Tiefe eingestellt ist, die die lichtemittierende Schicht 102 nicht erreicht. Dem ist so, weil, falls der konkave Abschnitt 101b die lichtemittierende Schicht 102 erreicht, das Volumen der lichtemittierenden Schicht 102 abnimmt und die Lichtemissionseffizienz abgesenkt wird. Außerdem kann die lichtemittierende Schicht 102 beschädigt werden, wenn jeder konkave Abschnitt 101b gebildet wird.

[0062] In dieser Konfiguration befindet sich die erste Elektrode 107, indem jede erste Elektrode 107 näher an die lichtemittierende Schicht 102 gebracht wird, noch näher an dem Elementmittelabschnitt, und es ist möglich, den Elementbereich zu reduzieren. Insbesondere, wenn eine verengte Breite w2 bezüglich der Breite H1 des lichtemittierenden Elements 300 gemäß dem Vergleichsbeispiel, ist die Breite w2 durch t2/tanθ dargestellt. Infolgedessen wird die Breite des lichtemittierenden Elements 100 von der Breite H1 zu einer Breite H3 reduziert.

[0063] Indem die erste Elektrode 107 näher an die lichtemittierend Schicht 102 gebracht wird, wird weiter der Bereich jeder Seitenoberfläche 101d jedes konkaven Abschnitts 101b größer, und der Kontaktbereich zwischen der ersten Elektrode 107 und der ersten Halbleiterschicht 101 nimmt zu, so dass ein Kontaktwiderstand zwischen jeder ersten Elektrode 107 und der ersten Halbleiterschicht 101 reduziert werden kann.

[0064] Außerdem kann jede erste Elektrode 107 von der Innenseite jedes konkaven Abschnitts 101b über der lichtemittierenden Oberfläche 101a angeordnet werden. Fig. 7 ist ein Querschnittsdiagramm, das jede über die lichtemittierenden Oberfläche 101a gebildete erste Elektrode 107 zeigt.

[0065] Wie in der gleichen Zeichnung gezeigt, weist jede erste Elektrode 107 einen ersten Abschnitt 107a und einen zweiten Abschnitt 107b auf. Der erste Abschnitt 107a ist in jedem konkaven Abschnitt 101b angeordnet und befindet sich näher an der lichtemit-

tierenden Schicht **102** als die lichtemittierende Oberfläche **101a**.

[0066] Jeder zweite Abschnitt 107b ist ein Abschnitt, der sich von jedem ersten Abschnitt 107a auf die lichtemittierende Oberfläche 101a erstreckt und die lichtemittierende Oberfläche 101a bedeckt. Jeder zweite Abschnitt 107b ist an einer Peripherie der lichtemittierenden Oberfläche 101a vorgesehen um die lichtemittierende Oberfläche 101a nicht abzuschirmen.

[0067] Durch Bilden jedes zweiten Abschnitts 107b auf der lichtemittierenden Oberfläche 101a wird der Kontaktbereich zwischen der ersten Elektrode 107 und der ersten Halbleiterschicht 101 weiter verbessert, so dass der Kontaktwiderstand zwischen jeder ersten Elektrode 107 und der ersten Halbleiterschicht 101 weiter reduziert werden kann.

[0068] Durch Reduzieren der Breite der Bodenoberfläche 101c ist es außerdem möglich, einen Abschirmbereich der lichtemittierenden Oberfläche 101a durch jede erste Elektrode 107 zu unterdrücken und einen Bereich der lichtemittierenden Oberfläche 101a (Breite S in der Zeichnung) beizubehalten.

[0069] Weiter kann in einem Fall, wo jede erste Elektrode 107 auf der lichtemittierenden Oberfläche 101a gebildet ist, ein Gebiet hoher Verunreinigung auf der Oberfläche der ersten Halbleiterschicht 101 gebildet werden. Fig. 8 ist ein Querschnittsdiagramm des lichtemittierenden Elements 100, in dem ein Gebiet 101e hoher Verunreinigung auf der Oberfläche der ersten Halbleiterschicht 101 gebildet ist.

[0070] Das Gebiet 101e hoher Verunreinigung ist ein mit Störatomen stark dotiertes Gebiet. Wenn die erste Halbleiterschicht 101 aus dem p-Halbleiter gebildet wird, kann es ein Gebiet sein, das mit p-Dotierstoffen wie etwa Zn und C stark dotiert ist. Wenn die erste Halbleiterschicht 101 aus dem n-Halbleiter gebildet wird, kann sie weiter ein Gebiet sein, das mit n-Dotierstoffen wie etwa Si stark dotiert ist.

[0071] Durch Bereitstellen des Gebiets 101e hoher Verunreinigung auf der Oberfläche der ersten Halbleiterschicht 101 kann eine Kontaktspannung zwischen jeder ersten Elektrode 107 und der ersten Halbleiterschicht 101 stabilisiert und reduziert werden.

[0072] Anstelle des Gebiets 101e hoher Verunreinigung kann übrigens eine transparente leitfähige Schicht auf der ersten Halbleiterschicht 101 laminiert werden. Fig. 9 ist ein Querschnittsdiagramm des lichtemittierenden Elements 100 einschließlich der transparenten leitfähigen Schicht 111. Die transparente leitfähige Schicht 111 kann aus einem lichtdurchlässigen leitfähigen dielektrischen Material wie etwa ITO (Indiumzinnoxid) gebildet werden.

[0073] Durch Kontaktieren jedes zweiten Abschnitts 107b jeder ersten Elektrode 107 mit der transparenten leitfähigen Schicht 111 kann die Kontaktspannung zwischen jeder ersten Elektrode 107 und der ersten Halbleiterschicht 101 stabilisiert und reduziert werden

[Verbindung der ersten Elektrode und der Seitenverdrahtung]

[0074] In der obigen Beschreibung kann, obwohl jede erste Elektrode 107 mit der Stirnoberfläche 106a der Seitenverdrahtung 106 in Kontakt steht (siehe Fig. 1), jede erste Elektrode 107 in Kontakt mit einem anderen Abschnitt als der Stirnoberfläche 106a der Seitenverdrahtung 106 stehen.

[0075] Fig. 10 ist ein Schemadiagramm, das eine Konfiguration zeigt, in der jede erste Elektrode 107 mit jeder inneren Oberfläche 106b der Seitenverdrahtung 106 in Kontakt steht. Jede innere Oberfläche 106b ist eine Oberfläche der Seitenverdrahtung 106 auf einer Seite des Laminats 110. Wie in der gleichen Zeichnung gezeigt, kann die Seitenverdrahtung 106 von der ersten Elektrode 107 zu der Seite der lichtemittierenden Oberfläche 101a vergrößert werden und eine Stirnoberfläche jeder ersten Elektrode 107 kann mit der inneren Oberfläche 106b in Kontakt gebracht werden (Filmoberfläche).

[0076] In der Konfiguration, in der jede erste Elektrode 107 die Stirnoberfläche 106a kontaktiert, wenn die Dicke der Seitenverdrahtung 106 reduziert ist, nimmt der Kontaktbereich zwischen jeder ersten Elektrode 107 und der Seitenverdrahtung 106 ab. Andererseits nimmt in der Konfiguration, in der jede erste Elektrode 107 jede innere Oberfläche 106b kontaktiert, sogar falls die Dicke der Seitenverdrahtung 106 reduziert ist, der Kontaktbereich zwischen jeder ersten Elektrode 107 und der Seitenverdrahtung 106 nicht ab.

[0077] Deshalb ist es möglich, die Seitenverdrahtung 106 zu reduzieren, während die Stabilität der elektrischen Verbindung zwischen jeder ersten Elektrode 107 und der Seitenverdrahtung 106 beibehalten wird, und den Elementbereich entsprechend zu reduzieren.

[0078] Weiter kann jede erste Elektrode 107 mit sowohl jeder inneren Oberfläche 106b als auch jeder Stirnoberfläche 106a der Seitenverdrahtung 106 in Kontakt stehen. Fig. 11 ist ein Schemadiagramm, das eine Konfiguration zeigt, in der jede erste Elektrode 107 jede innere Oberfläche 106b und jede Stirnoberfläche 106a der Seitenverdrahtung 106 kontaktiert.

[0079] In dieser Konfiguration ist es möglich, die elektrische Verbindung zwischen jeder der ersten Elektrode 107 und der Seitenverdrahtung 106 zu sta-

bilisieren und den Kontaktwiderstand weiter zu reduzieren.

[0080] Übrigens kann jede erste Elektrode 107 in dieser Konfiguration jeden zweiten Abschnitt 107b aufweisen, der die lichtemittierende Oberfläche 101a bedeckt. Fig. 12 ist ein Schemadiagramm, das eine Konfiguration zeigt, in der jede erste Elektrode 107 jede innere Oberfläche 106b und jede Stirnoberfläche 106a kontaktiert und die lichtemittierende Oberfläche 101a bedeckt.

[0081] Die lichtemittierende Oberfläche 101a ist mit dem Gebiet 101e hoher Verunreinigung versehen. In dieser Konfiguration kann der Kontaktwiderstand zwischen dem Gebiet 101e hoher Verunreinigung und jeder ersten Elektrode 107 reduziert werden, und der Kontaktwiderstand zwischen jeder ersten Elektrode 107 und der Seitenverdrahtung 106 kann reduziert werden.

[0082] Man beachte, dass eine transparente leitfähige Schicht 111 auf der lichtemittierenden Oberfläche 101a anstelle des Gebiets 101e hoher Verunreinigung laminiert werden kann, und das Gebiet 101e hoher Verunreinigung und die transparente leitfähige Schicht 111 werden möglicherweise nicht bereitgestellt.

[Planare Anordnung der ersten Elektrode]

[0083] Die planare Anordnung der ersten Elektrode 107 ist nicht auf die in Fig. 2 gezeigte beschränkt. Die Fig. 13 bis Fig. 15 sind Schemadiagramme, die ein Anordnungsbeispiel der ersten Elektrode 107 zeigen. Wie in Fig. 13 und Fig. 14 gezeigt, können die ersten Elektroden 107 auf vier Seiten des lichtemittierenden Elements 100 vorgesehen werden. Weiter kann, wie in Fig. 15 gezeigt, das lichtemittierende Element 100 so vorgesehen werden, dass es die Peripherie davon umgibt.

[0084] Jede der ersten Elektroden 107 kann eine beliebige der oben beschriebenen Strukturen aufweisen. Es ist möglich, die Elementbreite in allen der vier Seiten zu reduzieren, indem die erste Elektrode 107 auf allen vier Seiten vorgesehen wird. Übrigens ist die planare Gestalt des lichtemittierenden Elements 100 nicht auf ein Rechteck beschränkt und kann polygonal oder kreisförmig sein.

#### [Elektronikvorrichtung]

[0085] Das lichtemittierende Element 100 kann als ein lichtemittierendes Element verwendet werden, das auf einem Pixel eines Displays montiert ist, eine Beleuchtungslichtquelle und verschiedene andere Elektronikvorrichtungen. Wie oben beschrieben, kann das lichtemittierende Element 100 in dem Elementbereich reduziert werden, während der Bereich

der lichtemittierenden Oberfläche **101a** beibehalten wird, und kann mit hoher Dichte montiert werden. Weiter wird eine stabile elektrische Verbindung realisiert, es ist auch möglich, den Stromverbrauch zu reduzieren.

**[0086]** Die vorliegende Technologie kann auch die folgenden Strukturen aufweisen.

(1) Ein lichtemittierendes Element, enthaltend:

ein Laminat, bei dem eine erste Halbleiterschicht mit einem ersten Halbleitertyp, eine lichtemittierende Schicht und eine zweite Halbleiterschicht mit einem zweiten Halbleitertyp in dieser Reihenfolge laminiert sind einschließlich einer lichtemittierenden Oberfläche an einer Oberfläche gegenüber der lichtemittierenden Schicht der ersten Halbleiterschicht, von der in der lichtemittierenden Schicht erzeugtes Licht emittiert wird, einer nicht-lichtemittierenden Oberfläche an einer Oberfläche gegenüber der lichtemittierenden Schicht der zweiten Halbleiterschicht und einer Seitenoberfläche, die zwischen der lichtemittierenden Oberfläche und der nicht-lichtemittierenden Oberfläche verbindet, wobei die Seitenoberfläche so geneigt ist, dass eine Distanz zwischen den Seitenoberflächen aus einer Richtung senkrecht zu einer Schichtoberflächenrichtung des Laminats sich zu der lichtemittierenden Oberfläche erstreckt;

eine erste Elektrode, die elektrisch mit der ersten Halbleiterschicht verbunden ist, in einem konkaven Abschnitt angeordnet, der in der lichtemittierenden Oberfläche an einer Peripherie der ersten Halbleiterschicht vorgesehen ist, und mit einem Abschnitt, der näher an einer Seite der lichtemittierenden Schicht liegt als die lichtemittierende Oberfläche;

eine zweite Elektrode, die auf einer Seite der nicht-lichtemittierenden Oberfläche des Laminats vorgesehen und elektrisch mit dem zweiten Halbleiter verbunden ist;

eine dritte Elektrode, die auf der Seite der nichtlichtemittierenden Oberfläche des Laminats vorgesehen und von der zweiten Elektrode isoliert ist; und

eine Seitenverdrahtung, die die erste Elektrode und die dritte Elektrode über die Seitenoberfläche elektrisch verbindet.

(2) Das lichtemittierende Element nach (1), bei dem

eine Tiefe des konkaven Abschnitts von der lichtemittierenden Oberfläche größer ist als eine Dicke der ersten Halbleiterschicht zwischen der ersten Elektrode und der lichtemittierenden Schicht.

- (3) Das lichtemittierende Element nach (1) oder
- (2), bei dem

eine Gesamtheit der ersten Elektrode sich näher zu der Seite der lichtemittierenden Schicht befindet als die lichtemittierende Oberfläche.

- (4) Das lichtemittierende Element nach (1) oder
- (2), bei dem

die erste Elektrode einen ersten Abschnitt, der näher an der Seite der lichtemittierenden Schicht als die lichtemittierende Oberfläche liegt, und einen zweiten Abschnitt enthält, der auf der lichtemittierenden Oberfläche vorgesehen ist und die lichtemittierende Oberfläche bedeckt.

(5) Das lichtemittierende Element nach (4), bei dem

die erste Halbleiterschicht ein Gebiet hoher Verunreinigung auf der Seite der lichtemittierenden Oberfläche aufweist und der zweite Abschnitt mit dem Gebiet hoher Verunreinigung in Kontakt stehen kann.

(6) Das lichtemittierende Element nach (4), weiter enthaltend:

eine transparente leitfähige Schicht, die aus einem transparenten leitfähigen Material gebildet ist, die auf die lichtemittierende Oberfläche laminiert ist, und der zweite Abschnitt kann mit der transparenten leitfähigen Schicht in Kontakt stehen.

(7) Das lichtemittierende Element nach einem von (1) bis (4), bei dem

die erste Elektrode mit einer Stirnfläche der Seite der lichtemittierenden Oberfläche der Seitenverdrahtung in Kontakt steht.

(8) Das lichtemittierende Element nach einem von (1) bis (7), bei dem

die erste Elektrode mit einer inneren Oberfläche in Kontakt steht, die eine Oberfläche einer Laminatseite der Seitenverdrahtung ist.

(9) Das lichtemittierende Element nach einem von (4) bis (6), bei dem

der erste Abschnitt mit der inneren Oberfläche, die eine Oberfläche der Laminatseite der Seitenverdrahtung ist, und der Stirnfläche der Seite der lichtemittierenden Oberfläche der Seitenverdrahtung in Kontakt steht.

(10) Das lichtemittierende Element nach einem von (1) bis (9), enthaltend:

mehrere der ersten Elektroden.

(11) Eine Elektronikvorrichtung, enthaltend:

## DE 11 2019 004 265 T5 2021.05.12

ein lichtemittierendes Element einschließlich einem lichtemittierenden Element, enthaltend:

ein Laminat, bei dem eine erste Halbleiterschicht mit einem ersten Halbleitertyp, eine lichtemittierende Schicht und eine zweite Halbleiterschicht mit einem zweiten Halbleitertyp in dieser Reihenfolge laminiert sind einschließlich einer lichtemittierenden Oberfläche an einer Oberfläche gegenüber der lichtemittierenden Schicht der ersten Halbleiterschicht, von der in der lichtemittierenden Schicht erzeugtes Licht emittiert wird, einer nicht-lichtemittierenden Oberfläche an einer Oberfläche gegenüber der lichtemittierenden Schicht der zweiten Halbleiterschicht und einer Seitenoberfläche, die zwischen der lichtemittierenden Oberfläche und der nicht-lichtemittierenden Oberfläche verbindet, wobei die Seitenoberfläche so geneigt ist, dass eine Distanz zwischen den Seitenoberflächen aus einer Richtung senkrecht zu einer Schichtoberflächenrichtung des Laminats sich zu der lichtemittierenden Oberfläche erstreckt;

eine erste Elektrode, die elektrisch mit der ersten Halbleiterschicht verbunden ist, in einem konkaven Abschnitt angeordnet, der in der lichtemittierenden Oberfläche an einer Peripherie der ersten Halbleiterschicht vorgesehen ist, und mit einem Abschnitt, der näher an einer Seite der lichtemittierenden Schicht liegt als die lichtemittierende Oberfläche:

eine zweite Elektrode, die auf einer Seite der nicht-lichtemittierenden Oberfläche des Laminats vorgesehen und elektrisch mit dem zweiten Halbleiter verbunden ist;

eine dritte Elektrode, die auf der Seite der nichtlichtemittierenden Oberfläche des Laminats vorgesehen und von der zweiten Elektrode isoliert ist: und

eine Seitenverdrahtung, die die erste Elektrode und die dritte Elektrode über die Seitenoberfläche elektrisch verbindet.

#### Bezugszeichenliste

100	lichtemittierendes Element
101	erste Halbleiterschicht
101a	lichtemittierende Oberfläche
101b	konkaver Abschnitt
101e	Gebiet hoher Verunreinigung
102	lichtemittierende Schicht
103	zweite Halbleiterschicht
103a	nicht-lichtemittierende Oberfläche
106	Seitenverdrahtung

106a	Stirnoberfläche
106b	innere Oberfläche
107	erste Elektrode
107a	erster Abschnitt
107b	zweiter Abschnitt
108	zweite Elektrode
109	dritte Elektrode
110	Laminat
110a	Seitenoberfläche
444	trananaranta laitfähiga Cahiaht

## DE 11 2019 004 265 T5 2021.05.12

## ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

## **Zitierte Patentliteratur**

- JP 2013157496 [0005]

#### Patentansprüche

1. Lichtemittierendes Element, umfassend:

ein Laminat, bei dem eine erste Halbleiterschicht mit einem ersten Halbleitertyp, eine lichtemittierende Schicht und eine zweite Halbleiterschicht mit einem zweiten Halbleitertyp in dieser Reihenfolge laminiert sind einschließlich einer lichtemittierenden Oberfläche an einer Oberfläche gegenüber der lichtemittierenden Schicht der ersten Halbleiterschicht, von der in der lichtemittierenden Schicht erzeugtes Licht emittiert wird, einer nicht-lichtemittierenden Oberfläche an einer Oberfläche gegenüber der lichtemittierenden Schicht der zweiten Halbleiterschicht und einer Seitenoberfläche, die zwischen der lichtemittierenden Oberfläche und der nicht-lichtemittierenden Oberfläche verbindet, wobei die Seitenoberfläche so geneigt ist, dass eine Distanz zwischen den Seitenoberflächen aus einer Richtung senkrecht zu einer Schichtoberflächenrichtung des Laminats sich zu der lichtemittierenden Oberfläche erstreckt;

eine erste Elektrode, die elektrisch mit der ersten Halbleiterschicht verbunden ist, in einem konkaven Abschnitt angeordnet, der in der lichtemittierenden Oberfläche an einer Peripherie der ersten Halbleiterschicht vorgesehen ist, und mit einem Abschnitt, der näher an einer Seite der lichtemittierenden Schicht liegt als die lichtemittierende Oberfläche;

eine zweite Elektrode, die auf einer Seite der nichtlichtemittierenden Oberfläche des Laminats vorgesehen und elektrisch mit dem zweiten Halbleiter verbunden ist:

eine dritte Elektrode, die auf der Seite der nicht-lichtemittierenden Oberfläche des Laminats vorgesehen und von der zweiten Elektrode isoliert ist; und eine Seitenverdrahtung, die die erste Elektrode und die dritte Elektrode über die Seitenoberfläche elektrisch verbindet.

- 2. Lichtemittierendes Element nach Anspruch 1, wobei eine Tiefe des konkaven Abschnitts von der lichtemittierenden Oberfläche größer ist als eine Dicke der ersten Halbleiterschicht zwischen der ersten Elektrode und der lichtemittierenden Schicht.
- 3. Lichtemittierendes Element nach Anspruch 1, wobei eine Gesamtheit der ersten Elektrode sich näher zu der Seite der lichtemittierenden Schicht als die lichtemittierende Oberfläche befindet.
- 4. Lichtemittierendes Element nach Anspruch 1, wobei die erste Elektrode einen ersten Abschnitt, der näher an der Seite der lichtemittierenden Schicht als die lichtemittierende Oberfläche liegt, und einen zweiten Abschnitt enthält, der auf der lichtemittierenden Oberfläche vorgesehen ist und die lichtemittierende Oberfläche bedeckt.
- 5. Lichtemittierendes Element nach Anspruch 4, wobei die erste Halbleiterschicht ein Gebiet hoher

Verunreinigung auf der Seite der lichtemittierenden Oberfläche aufweist und der zweite Abschnitt mit dem Gebiet hoher Verunreinigung in Kontakt stehen kann.

- 6. Lichtemittierendes Element nach Anspruch 4, weiter umfassend:
- eine transparente leitfähige Schicht, die aus einem transparenten leitfähigen Material gebildet ist, die auf die lichtemittierende Oberfläche laminiert ist, und der zweite Abschnitt kann mit der transparenten leitfähigen Schicht in Kontakt stehen.
- 7. Lichtemittierendes Element nach Anspruch 1, wobei die erste Elektrode mit einer Stirnfläche der Seite der lichtemittierenden Oberfläche der Seitenverdrahtung in Kontakt steht.
- 8. Lichtemittierendes Element nach Anspruch 1, wobei die erste Elektrode mit einer inneren Oberfläche in Kontakt steht, die eine Oberfläche einer Laminatseite der Seitenverdrahtung ist.
- 9. Lichtemittierendes Element nach Anspruch 4, wobei der erste Abschnitt mit der inneren Oberfläche, die eine Oberfläche der Laminatseite der Seitenverdrahtung ist, und der Stirnfläche der Seite der lichtemittierenden Oberfläche der Seitenverdrahtung in Kontakt steht.
- 10. Lichtemittierendes Element nach Anspruch 1, umfassend: mehrere der ersten Elektroden.
  - 11. Elektronikvorrichtung, umfassend:

ein lichtemittierendes Element einschließlich einem lichtemittierenden Element, enthaltend:

ein Laminat, bei dem eine erste Halbleiterschicht mit einem ersten Halbleitertyp, eine lichtemittierende Schicht und eine zweite Halbleiterschicht mit einem zweiten Halbleitertyp in dieser Reihenfolge laminiert sind einschließlich einer lichtemittierenden Oberfläche an einer Oberfläche gegenüber der lichtemittierenden Schicht der ersten Halbleiterschicht, von der in der lichtemittierenden Schicht erzeugtes Licht emittiert wird, einer nicht-lichtemittierenden Oberfläche an einer Oberfläche gegenüber der lichtemittierenden Schicht der zweiten Halbleiterschicht und einer Seitenoberfläche, die zwischen der lichtemittierenden Oberfläche und der nicht-lichtemittierenden Oberfläche verbindet, wobei die Seitenoberfläche so geneigt ist, dass eine Distanz zwischen den Seitenoberflächen aus einer Richtung senkrecht zu einer Schichtoberflächenrichtung des Laminats sich zu der lichtemittierenden Oberfläche erstreckt;

eine erste Elektrode, die elektrisch mit der ersten Halbleiterschicht verbunden ist, in einem konkaven Abschnitt angeordnet, der in der lichtemittierenden Oberfläche an einer Peripherie der ersten Halbleiterschicht vorgesehen ist, und mit einem Abschnitt, der

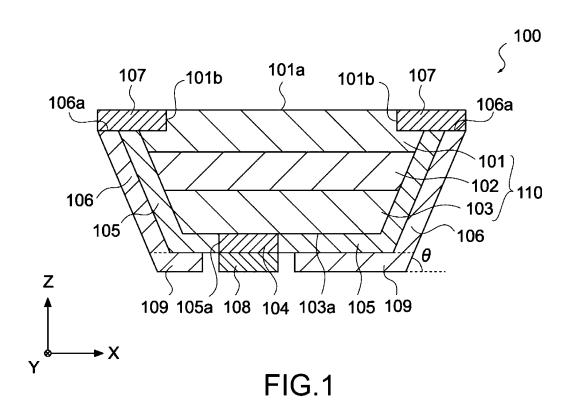
## DE 11 2019 004 265 T5 2021.05.12

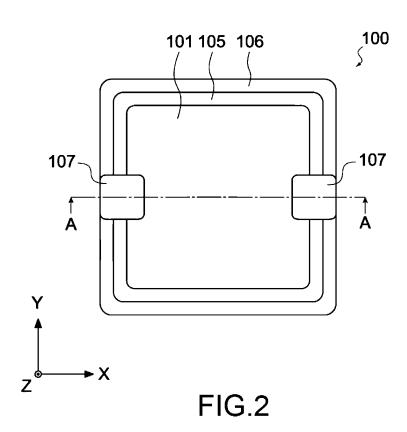
näher an einer Seite der lichtemittierenden Schicht liegt als die lichtemittierende Oberfläche; eine zweite Elektrode, die auf einer Seite der nichtlichtemittierenden Oberfläche des Laminats vorgesehen und elektrisch mit dem zweiten Halbleiter verbunden ist;

eine dritte Elektrode, die auf der Seite der nicht-lichtemittierenden Oberfläche des Laminats vorgesehen und von der zweiten Elektrode isoliert ist; und eine Seitenverdrahtung, die die erste Elektrode und die dritte Elektrode über die Seitenoberfläche elektrisch verbindet.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen

## Anhängende Zeichnungen





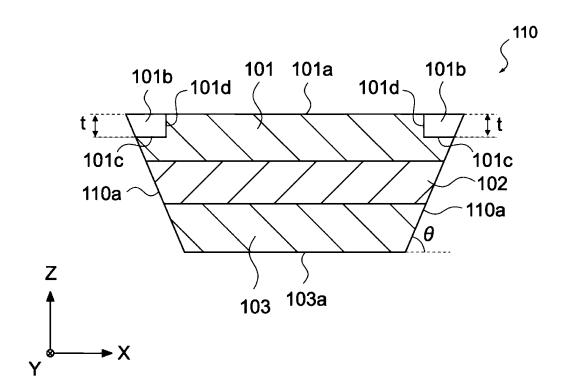
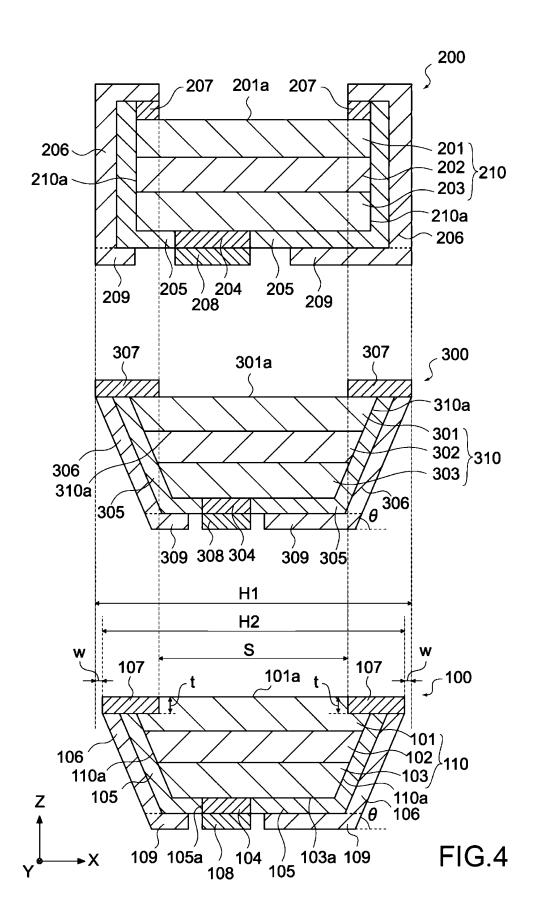
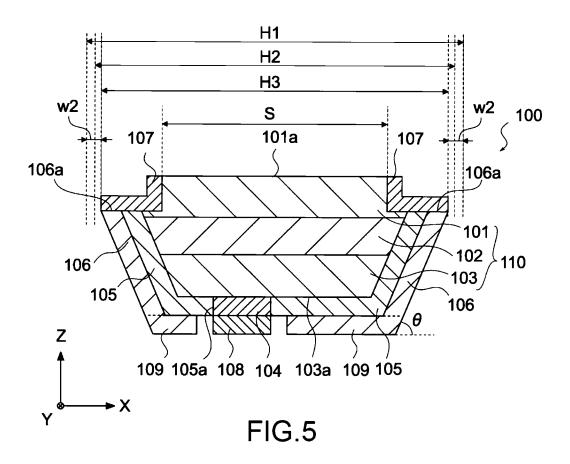
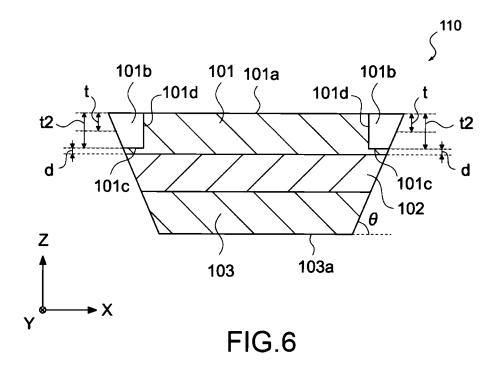
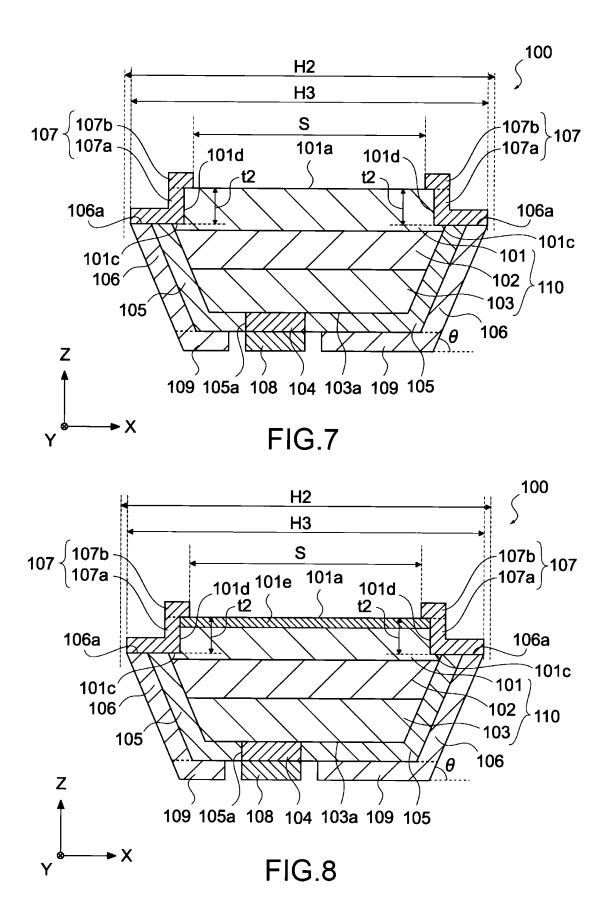


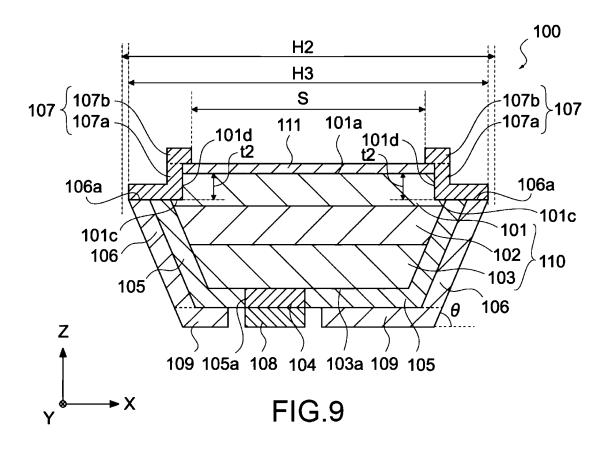
FIG.3

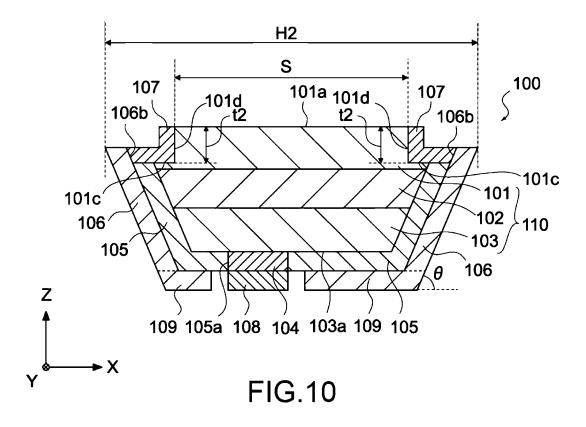


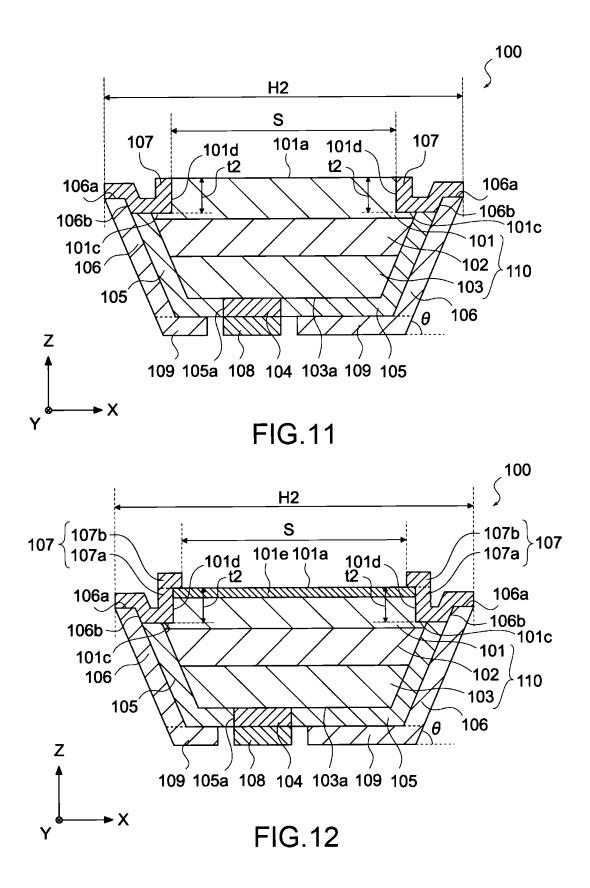


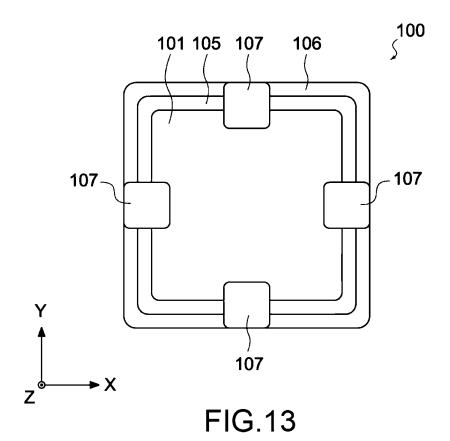


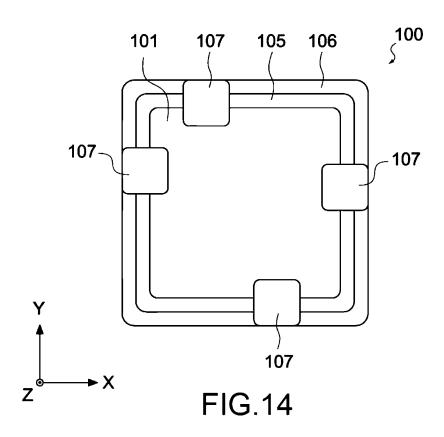












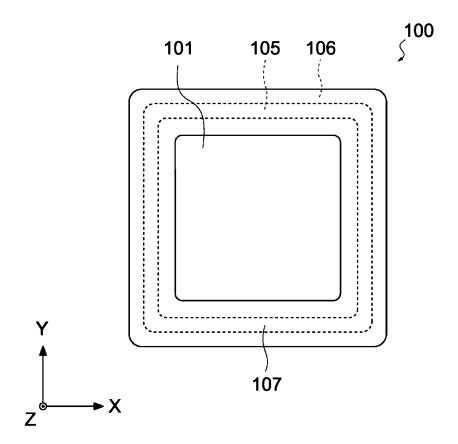


FIG.15